(A1)

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Bureau international

G00002

(43) Date de la publication internationale
30 mai 2002 (30.05.2002)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 02/043124 A3

(51) Classification internationale des brevets[7] :
H01L 21/20, 21/302, 29/165, 29/205, 29/267

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR01/03715

(22) Date de dépôt international :
26 novembre 2001 (26.11.2001)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
00/15280 27 novembre 2000 (27.11.2000) FR

(71) Déposant *(pour tous les Etats désignés sauf US)* : **S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES** [FR/FR], Parc Technologique des Fontaines, Chemin des Franques, F-38190 Bernin (FR)

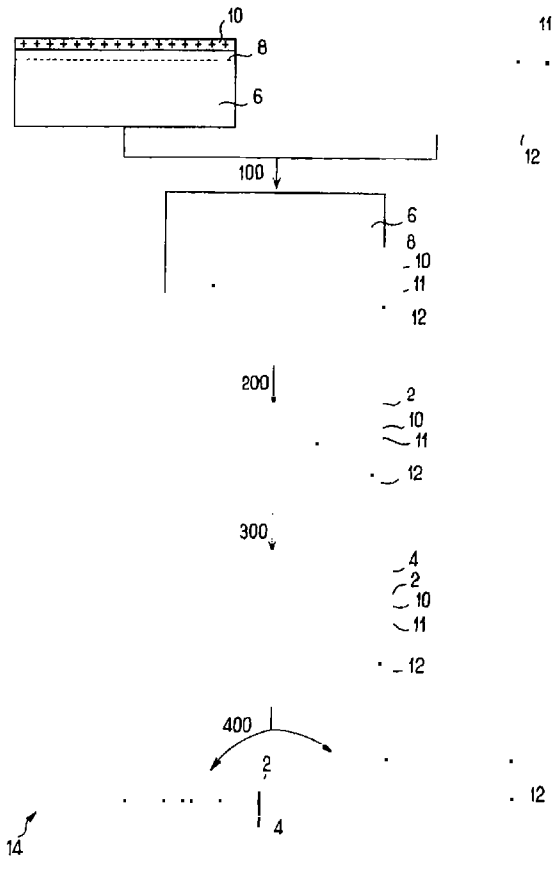
(72) Inventeurs; et
(75) Inventeurs/Déposants *(pour US seulement)* : **GHYSELEN, Bruno** [FR/FR], 58, rue Georges Maeder, F-38170 Seyssinet (FR) **LETERTRE, Fabrice** [FR/FR], 33 quai Jongkind, F-38000 GRENOBLE (FR)

(74) Mandataires : **MARTIN, Jean-Jacques** etc., Cabinet Regimbeau, 20, rue de Chazelles, F-75847 Paris Cedex 17 (FR)

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD FOR MAKING A SUBSTRATE IN PARTICULAR FOR OPTICS, ELECTRONICS OR OPTOELECTRONICS AND RESULTING SUBSTRATE

(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D'UN SUBSTRAT CONTENANT UNE COUCHE MINCE SUR UN SUPPORT ET SUBSTRAT OBTENU PAR CE PROCEDE



(57) Abstract: The invention concerns a method for making a substrate comprising a thin layer borne by a layer forming a mechanical support, in particular for optics, electronics or optoelectronics. The invention is characterised in that the method comprises the following steps removing from a source substrate (6) a layer of a material to form the thin layer (2), then producing on the thin layer (2) a deposition of material in a thick layer (4) to form the layer forming the mechanical support

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'un substrat comprenant une couche mince portée par une couche constituant un support mécanique, notamment pour l'optique, l'électronique ou l'optoélectronique. Selon l'invention, le procédé comprenant les étapes suivantes. - détacher d'un substrat source (6) une couche d'un matériau pour former la couche mince (2), puis - réaliser sur la couche mince (2) un dépôt de matériau en une couche épaisse (4) pour former la couche constituant le support mécanique

162162

WO 02/043124 A3

(81) **États désignés** *(national)* : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(84) **États désignés** *(régional)* : brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

Déclaration en vertu de la règle 4.17 :

— *relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17 iv)) pour US seulement*

Publiée :

— *avec rapport de recherche internationale*

— *avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues*

(88) **Date de publication du rapport de recherche internationale:** 22 août 2002

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT